

>= 个人简历 =<

【 资料 】

- 姓名： 张雄
- 性别： 男
- 出生年月： 1962年11月
- 职称： 教授，博士生导师
- 学历： 博士
- 职务：
- 联系电话： 025-83792470-823
- Email : elezx@yahoo.com



【研究方向】

近20年来一直从事化合物半导体材料和器件,如LED,HBT,半导体激光器等的研发工作。目前正在开展以氮化镓(GaN)为基础的宽禁带半导体材料和器件,特别是高亮度LED的研发工作。

【 经历 】

1980年以江西省高考总分第四名(物理99分)的成绩考入中国科技大学物理系；1987年获日本文部省奖学金赴日本东京大学攻读博士学位；1992年获工学博士学位；1992年4月至1996年7月在日本奥林巴斯株式会社任主管工程师。在此期间，因发明专利众多(包括日本专利七项和美国专利一项)，获颁1994年公司最高荣誉奖---奥林巴斯社长(总裁)奖；1996至2000年，以李光耀博士后身份，在新加坡国立大学电子工程系任高级研究员。在此期间，出版英文学术专著二部，获得美国和新加坡授权专利各一项以及发表SCI收录学术论文二十余篇；2000至2003年在美国硅谷高科技公司Nova Crystals任高级工程师，从事蓝光LED的晶体生长和工艺技术以及光通讯用面发光半导体激光器的研发工作；2004至2006年在加拿大Simon Fraser大学MOCVD研究中心任研究科学家，从事GaAsSb异质结双极晶体管(HBT)的研发工作；2006至2008年回国任无锡蓝星电子有限公司总经理，主持氮化镓基高亮度蓝光LED的研发工作；2009年2月起任东南大学电子科学与工程学院教授,博士生导师。

【 研究成果 】

自1987年10月在日本东京大学应用物理系攻读博士学位起，一直从事以砷化镓，磷化铟和氮化镓等为基础的化合物半导体材料的MOCVD外延生长和相关光电子器件，如LED，光调制器，面发光激光器和异质结双极晶体管（HBT）的工艺研发工作，迄今已逾二十年。取得的主要成果有：发表在Appl. Phys. Lett., J. Appl. Phys., J. Crystal Growth, IEEE J. Quantum Electronics等国际一流刊物上的SCI论文28篇；英文学术专著2部；美国授权专利2项，新加坡授权专利1项，日本申请专利7项，中国申请专利1项。荣获日本政府文部省国费留学生奖学金，新加坡李光耀博士后奖学金（全新加坡每年仅四人获此殊荣），日本奥林巴斯公司最高荣誉奖—社长奖，并于2007年被授予江苏省首批引进的高层次创新创业人才奖。